

TCR3LM シリーズ

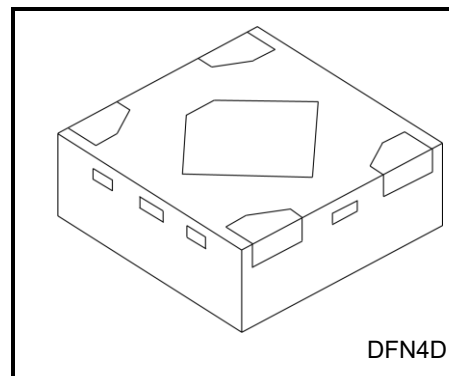
Low quiescent current, 300 mA CMOS Low Dropout Regulator in ultra small package

1. 概要

TCR3LM シリーズは低バイアス電流、低ドロップアウト、コントロール端子付き、CMOS プロセスのシングル出力 LDO レギュレーターです。

出力電圧は電圧固定タイプで 0.8 V から 5.0 V まで選択可能であり、出力電流は最大 300 mA まで出力可能です。過電流保護機能、過熱保護機能、オートディスチャージ機能を搭載しております。

また、パッケージは DFN4D (1.0 mm x 1.0 mm; t 0.37 mm (標準)) と超小型パッケージを採用しながらも低バイアス電流 (1.2 μ A (標準) @ $I_{OUT} = 0$ mA) も実現しております。入力・出力コンデンサはともに 0.47 μ F の小型セラミックタイプが使用可能であるため、携帯機器、IoT 機器、ウェアラブル端末などの高密度実装が求められるアプリケーションに最適です。



質量: 1.1 mg (標準)

2. アプリケーション

携帯機器、IoT 機器、ウェアラブル端末などの電源用途

3. 特長

- 超小型パッケージです (DFN4D (1.0 mm x 1.0 mm; t 0.37 mm (標準)))
- 低バイアス電流です ($I_{B(ON)} = 1.2 \mu$ A (標準) @ $I_{OUT} = 0$ mA)
- 高リップル圧縮度です (74 dB (標準) @100 Hz, 0.8 V 出力)
- 高速負荷過渡応答です ($-70/+35$ mV @2.8 V 出力, $I_{OUT} = 1$ mA $\leftrightarrow$ 100 mA)
- 低ドロップアウト電圧です ($V_{DO} = 213$ mV (標準) @2.8 V 出力, $I_{OUT} = 200$ mA)
- 幅広い出力電圧ラインアップです ($V_{OUT} = 0.8 \sim 5.0$ V)
- 過電流保護回路内蔵です
- 過熱保護回路内蔵です
- オートディスチャージ機能内蔵です
- 突入電流抑制回路内蔵です
- コントロール端子はプルダウン接続です
- セラミックコンデンサを使用可能です ($C_{IN} = 0.47 \mu$ F, $C_{OUT} = 0.47 \mu$ F)

製品量産開始時期
2023-03

4. 絶対最大定格 (注) ($T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)

項 目	記 号	定 格	単 位
入 力 電 圧	V_{IN}	$-0.3 \sim 6.0$	V
コ ン ト ロ ー ル 電 圧	V_{CT}	$-0.3 \sim V_{IN} + 0.3 \leq 6.0$	V
出 力 電 圧	V_{OUT}	$-0.3 \sim V_{IN} + 0.3 \leq 6.0$	V
許 容 損 失	P_D	420 (注 1)	mW
接 合 温 度	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	$-55 \sim 150$	$^{\circ}\text{C}$

注: 本製品の使用条件(使用温度/電流/電圧など)が絶対最大定格/動作範囲以内での使用においても、高負荷(高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等)で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。

弊社半導体信頼性ハンドブック(取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法)および個別信頼性情報(信頼性試験レポート、推定故障率等)をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注 1: 基板実装時

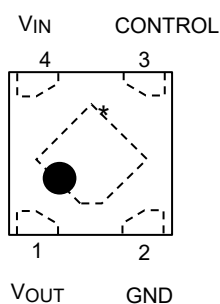
基板材質: ガラスエポキシ(FR4)

基板面積: 40 mm x 40 mm (両面基板), $t = 1.6\text{ mm}$

配線率: 表面 約 50 %, 裏面 約 50 %

スルーホール: 直径 0.5 mm x 24 個

5. 端子接続図 (Top view)



・パッケージ裏面の「*」印の中央電極部は GND または Open 接続にしてください。

6. 動作範囲

項 目	記 号	定 格	単 位
入 力 電 圧	V_{IN}	1.4 ~ 5.5 (注 2)	V
コ ン ト ロ ー ル 電 圧	V_{CT}	$0 \sim V_{IN}$	V
出 力 電 圧	V_{OUT}	0.8 ~ 5.0	V
出 力 電 流	I_{OUT}	DC 300	mA
動 作 温 度	T_{opr}	$-40 \sim 85$	$^{\circ}\text{C}$
出 力 コ ン デ ン サ ー 容 量	C_{OUT}	≥ 0.47	μF
入 力 コ ン デ ン サ ー 容 量	C_{IN}	≥ 0.47	μF

注 2: ドロップアウト電圧の特性をご参照の上、絶対最大定格の接合温度、及び、動作温度の範囲内でご使用ください。

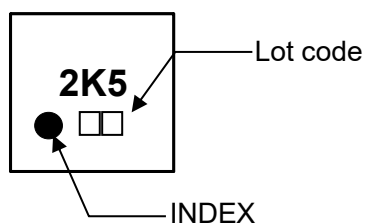
7. 品名、出力電圧、現品表示一覧表

品 名	出力電圧 (V)	現品表示
TCR3LM08A	0.8	0K8
TCR3LM085A	0.85	0KC
TCR3LM09A	0.9	0K9
TCR3LM095A	0.95	0KD
TCR3LM10A	1.0	1K0
TCR3LM105A	1.05	1KE
TCR3LM11A	1.1	1K1
TCR3LM115A	1.15	1KF
TCR3LM12A	1.2	1K2
TCR3LM13A	1.3	1K3
TCR3LM15A	1.5	1K5
TCR3LM16A	1.6	1K6
TCR3LM17A	1.7	1K7
TCR3LM18A	1.8	1K8
TCR3LM185A	1.85	1KH
TCR3LM19A	1.9	1K9
TCR3LM195A	1.95	1KK
TCR3LM20A	2.0	2K0
TCR3LM22A	2.2	2K2
TCR3LM25A	2.5	2K5
TCR3LM26A	2.6	2K6
TCR3LM27A	2.7	2K7
TCR3LM28A	2.8	2K8
TCR3LM285A	2.85	2KJ
TCR3LM29A	2.9	2K9
TCR3LM30A	3.0	3K0
TCR3LM31A	3.1	3K1
TCR3LM32A	3.2	3K2
TCR3LM33A	3.3	3K3
TCR3LM35A	3.5	3K5
TCR3LM36A	3.6	3K6
TCR3LM40A	4.0	4K0
TCR3LM41A	4.1	4K1
TCR3LM42A	4.2	4K2
TCR3LM45A	4.5	4K5
TCR3LM48A	4.8	4K8
TCR3LM50A	5.0	5K0

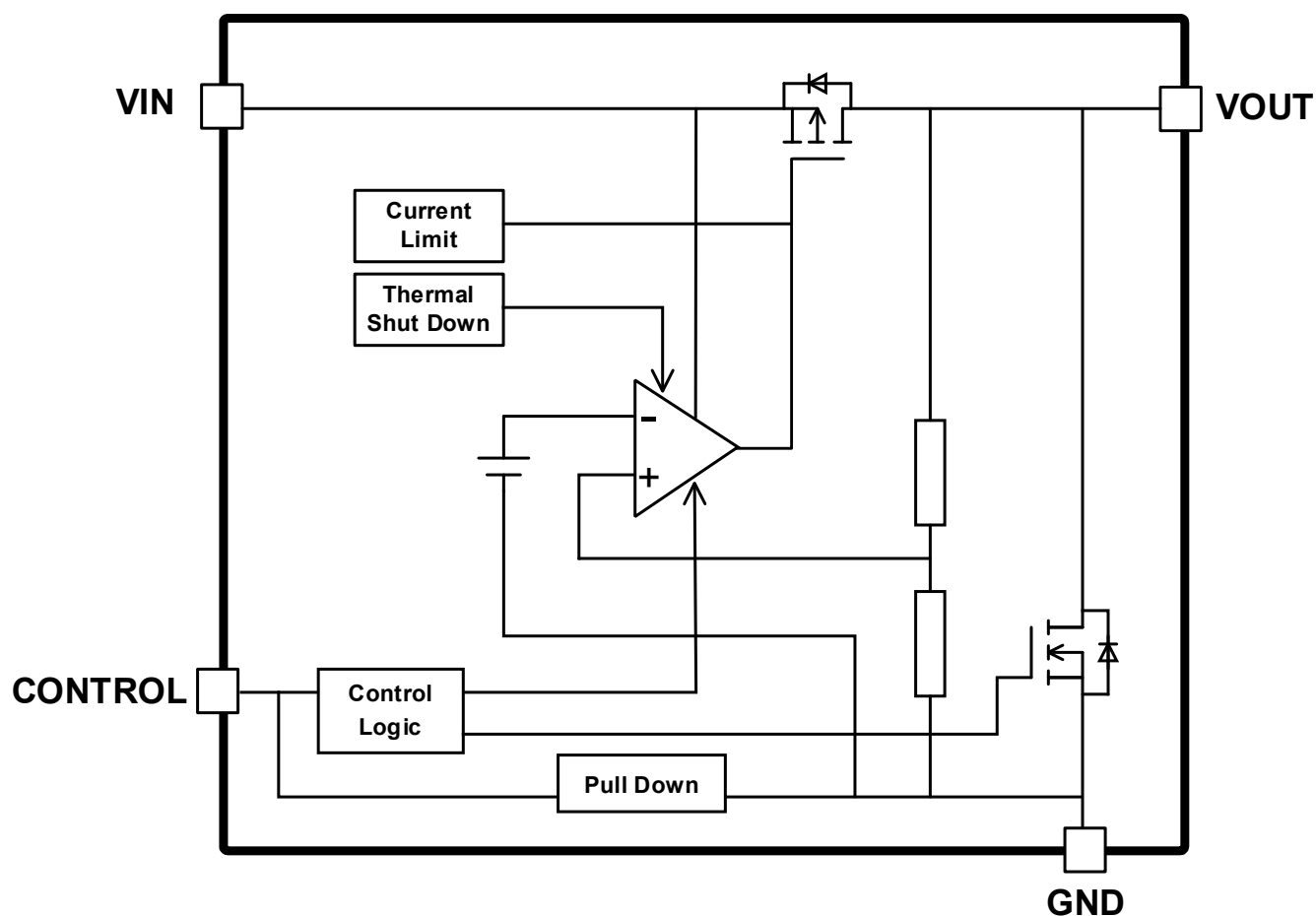
その他の電圧ランクをご希望の場合は、弊社営業部までお問い合わせください。

8. 現品表示 (Top view)

(例) TCR3LM25A (2.5 V 出力)



9. ブロック図



10. 電気的特性

(特に指定が無い場合, $V_{IN} = 2.5 \text{ V}$ or $V_{OUT} + 1.0 \text{ V}$ (いずれか大きい方), $V_{IN} = 5.5 \text{ V}$ ($V_{OUT} = 5.0 \text{ V}$),
 $C_{IN} = C_{OUT} = 0.47 \text{ }\mu\text{F}$)

項 目	記 号	測 定 条 件		$T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$			$T_J = -40 \sim 85 \text{ }^\circ\text{C}$ (注 8)		単 位
				最小	標準	最大	最小	最大	
出 力 電 圧 精 度	V_{OUT}	$I_{OUT} = 50 \text{ mA}$ $V_{IN} = V_{OUT} + 1 \text{ V}$ (注 3)	$V_{OUT} < 1.8 \text{ V}$	-18	—	+18	—	—	mV
			$1.8 \text{ V} \leq V_{OUT}$	-1	—	+1	—	—	%
入 力 安 定 度	Reg·line	$V_{OUT} + 1 \text{ V} \leq V_{IN} \leq 5.5 \text{ V}$ $I_{OUT} = 1 \text{ mA}$		—	5	—	—	12	mV
負 荷 安 定 度	Reg·load	$1 \text{ mA} \leq I_{OUT} \leq 200 \text{ mA}$ (注 4)		—	13	—	—	28	mV
バ イ ア ス 電 流	$I_B(\text{ON})$	$I_{OUT} = 0 \text{ mA}$, $V_{IN} = 5.5 \text{ V}$ (注 6)		—	1.2	—	—	2.2	μA
ス タ ン バ イ 電 流	$I_B(\text{OFF})$	$V_{CT} = 0 \text{ V}$, $V_{IN} = 5.5 \text{ V}$ (注 6)		—	0.1	—	—	0.2	μA
コントロールプルダウン電流	I_{CT}	—		—	0.1	—	—	0.2	μA
ドロップアウト電圧 (注 9)	V_{DO}	$I_{OUT} = 200 \text{ mA}$	$V_{OUT} = 1.8 \text{ V}$	—	344	—	—	445	mV
			$V_{OUT} = 2.8 \text{ V}$	—	213	—	—	290	mV
			$V_{OUT} = 3.3 \text{ V}$	—	177	—	—	251	mV
			$V_{OUT} = 5.0 \text{ V}$	—	137	—	—	205	mV
出 力 雑 音 電 圧	V_{NO}	$V_{IN} = V_{OUT} + 1 \text{ V}$ $I_{OUT} = 10 \text{ mA}$ $10 \text{ Hz} \leq f \leq 100 \text{ kHz}$, $T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ (注 4)		—	53	—	—	—	μV_{rms}
リ ッ プ ル 圧 縮 度	R.R.	$V_{IN} = V_{OUT} + 1 \text{ V}$ $I_{OUT} = 10 \text{ mA}$, $V_{\text{Ripple}} = 200 \text{ mV}_{\text{p-p}}$, $T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ (注 4)	$f = 100 \text{ Hz}$	—	74	—	—	—	dB
			$f = 1 \text{ kHz}$	—	66	—	—	—	
			$f = 10 \text{ kHz}$	—	50	—	—	—	
			$f = 100 \text{ kHz}$	—	43	—	—	—	
負 荷 過 渡 応 答	ΔV_{OUT}	$I_{OUT} = 1 \text{ mA} \rightarrow 100 \text{ mA}$ (注 5)		—	-70	—	—	—	mV
		$I_{OUT} = 100 \text{ mA} \rightarrow 1 \text{ mA}$ (注 5)		—	+35	—	—	—	
出 力 制 限 電 流	I_{CL}	$V_{OUT} = V_{OUT(\text{NOM})} * 90 \%$ (注 7)		—	—	—	300	450	mA
過 熱 保 護 温 度	T_{SDH}	T_J rising		—	160	—	—	—	$^\circ\text{C}$
	T_{SDL}	T_J falling		—	140	—	—	—	$^\circ\text{C}$
コントロール電圧 (HIGH)	V_{CTH}	コントロール端子入力電圧 “HIGH”		—	—	—	0.9	5.0	V
コントロール電圧 (LOW)	V_{CTL}	コントロール端子入力電圧 “LOW”		—	—	—	—	0.4	V
ディスチャージオン抵抗	R_{SD}	(注 5)		—	25	—	—	—	Ω

注 3: I_{OUT} を固定し、十分に出力電圧が安定した状態での規定値です。

注 4: $V_{OUT} = 0.8 \text{ V}$

注 5: $V_{OUT} = 2.8 \text{ V}$

注 6: コントロールプルダウン電流 (I_{CT})は含みません。

注 7: パルス測定

注 8: このパラメーターは設計的に保証される項目です。

注 9: $V_{DO} = V_{IN1} - (V_{OUT1} \times 0.97)$

V_{OUT1} は $V_{IN} = V_{OUT} + 1.0 \text{ V}$ の時の出力電圧です。

V_{IN1} は入力電圧を徐々に下げていき出力電圧が V_{OUT1} の 97%に降下した時点での入力電圧値です。

11. 出力電圧別ドロップアウト電圧表

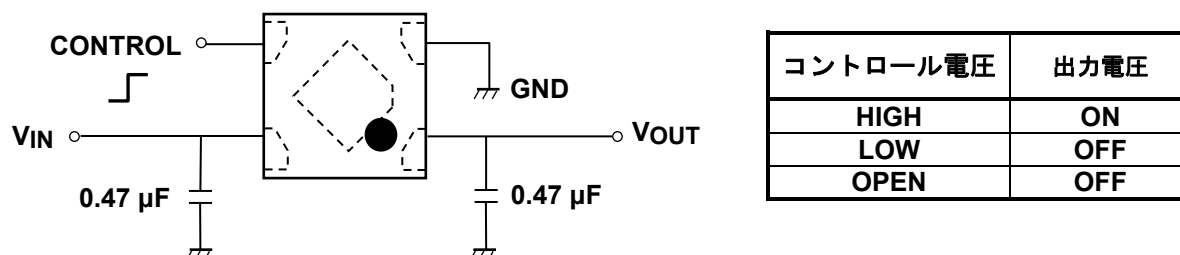
(C_{IN} = 0.47 μ F, C_{OUT} = 0.47 μ F)

出力電圧	I _{OUT} = 200 mA			単位
	最小	標準	最大 (注 10)	
0.8 V $\leq$ V _{OUT} < 1.5 V	—	(注 11)	(注 11)	mV
1.5 V	—	500 (注 11)	615 (注 11)	mV
1.6 V	—	441	550	mV
1.7 V	—	382	485	mV
1.8 V, 1.85 V	—	344	445	mV
1.9 V, 1.95 V	—	331	425	mV
2.0 V	—	318	410	mV
2.2 V	—	291	375	mV
2.5 V	—	252	325	mV
2.6 V	—	239	310	mV
2.7 V	—	226	300	mV
2.8 V, 2.85 V	—	213	290	mV
2.9 V	—	202	282	mV
3.0 V, 3.1 V	—	192	274	mV
3.2 V	—	182	259	mV
3.3 V	—	177	251	mV
3.5 V, 3.6 V	—	173	244	mV
4.0 V	—	161	237	mV
4.1 V		158	234	mV
4.2 V	—	156	230	mV
4.5 V	—	149	221	mV
4.8 V	—	142	211	mV
5.0 V	—	137	205	mV

注 10: T_j = -40 ~ 85 °C (このパラメーターは設計的に保証される項目です。)注 11: 動作入力電圧 V_{IN} は 2.5 V 以上で使用してください。

12. アプリケーションノート

12.1. 推奨回路例



上図に低ドロップアウトレギュレーターの推奨回路例を示します。 V_{IN} および V_{OUT} 端子には安定動作のためコンデンサを接続してください（セラミックコンデンサの使用が可能です）。

12.2. 許容損失

TCR3LM シリーズの許容損失は基板実装時を絶対最大定格で規定しております。実装基板の仕様を以下に示します。

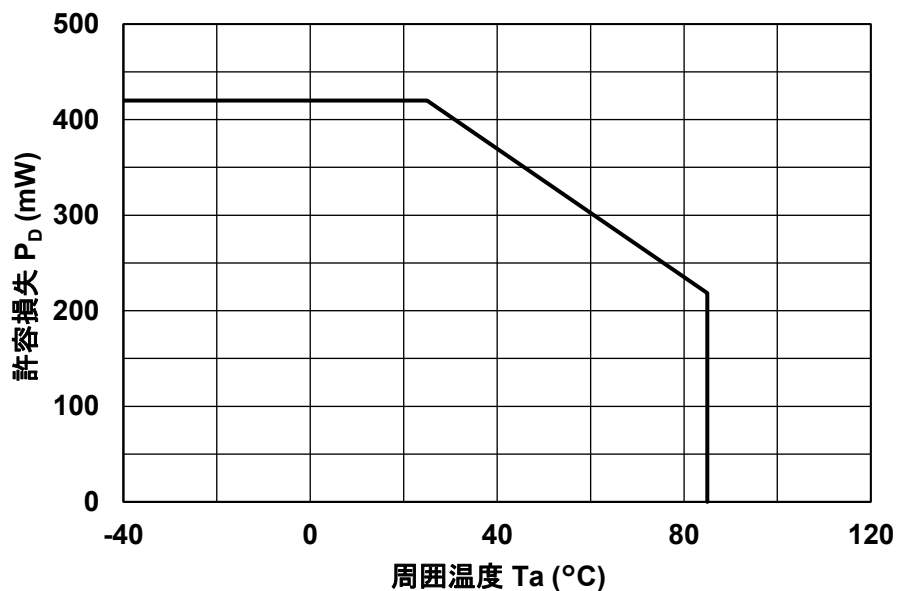
【基板条件】

基板材質：ガラスエポキシ(FR4)

基板面積：40 mm x 40 mm (両面基板), $t = 1.6$ mm

配線率：表面 約 50 %, 裏面 約 50 %

スルーホール：直径 0.5 mm x 24 個



12.3. ご使用上の注意

- 出力コンデンサについて

本製品はセラミックコンデンサが使用可能ですが、種類によっては非常に大きな温度特性を持つ場合もあります。コンデンサの選定にあたっては、使用環境を十分に考慮し、選定してください。また、セラミックコンデンサの使用を推奨します。

- バイアス電流特性について

TCR3LMシリーズのバイアス電流 $I_{B(ON)}$ は出力電流 I_{OUT} によって制御されます。 I_{OUT} が低い場合、TCR3LMシリーズは低 $I_{B(ON)}$ で動作しますが、この状態では負荷過渡応答特性が通常時より劣ります。 I_{OUT} による $I_{B(ON)}$ の切り替えは、ヒステリシスに制御されます。 I_{OUT} が増加し高 $I_{B(ON)}$ になった場合、良好な負荷過渡応答特性を示します。本特性は、 I_{OUT} が低下し低 $I_{B(ON)}$ に切り替わるまで維持されます。

- 実装について

IC と入力・出力コンデンサの距離が長いと、この配線抵抗のインピーダンスや L 成分により位相補償に影響を及ぼす可能性があります。より安定した電源にするため、入力・出力コンデンサはできるだけ IC の近くに実装し、VIN と GND パターンはできるだけ大きくして配線インピーダンスを小さくしてください。

- 許容損失について

実使用状態では予想される最大許容損失に対して、できるだけ余裕を持った基板パターン設計をしてください。また、実際のご使用の際には周囲温度、入力電圧、出力電流等のパラメーターを考慮の上、最大許容損失に対して、適当なディレーティング（一般的には最大値の 70~80%）を考慮した設計をお願いします。

- 過電流保護回路、過熱保護回路について

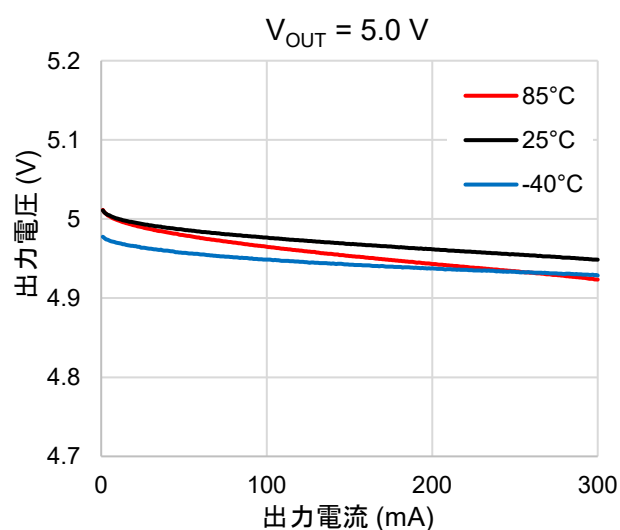
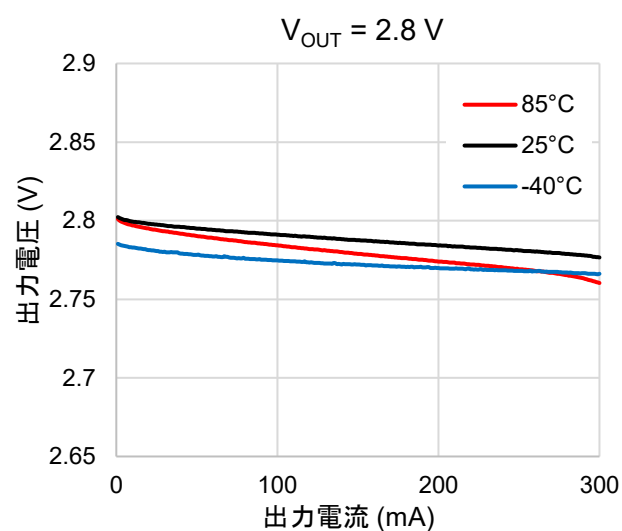
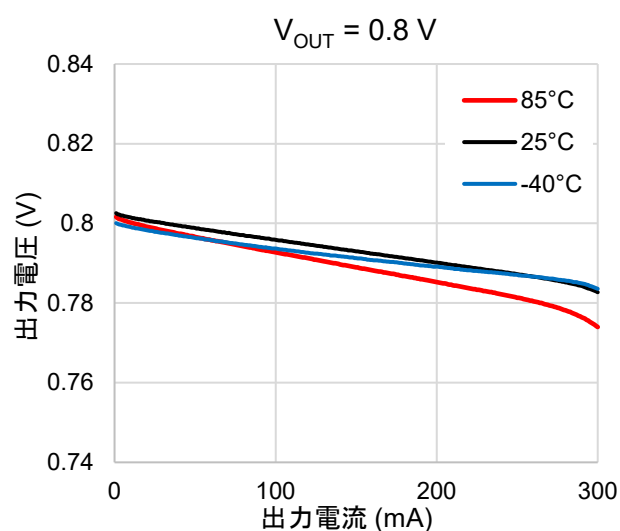
本製品はフォールドバックタイプの過電流保護回路、過熱保護回路を内蔵しておりますが、デバイスの動作を常に絶対最大定格内に抑える事を保証するものではありません。ご使用条件によっては製品仕様や信頼性保証に影響を与える可能性があります。また、本デバイスの出力端子と GND 端子間が不完全なショートモードに陥った場合、本デバイスが破壊に至るおそれがあります。

本デバイスのご使用にあたっては、上記および当社「半導体信頼性ハンドブック」等に記載の絶対最大定格に対するディレーティングを考慮の上、いかなる場合においても絶対最大定格を超えないようご注意ください。なお、セットにおいてフェールセーフ等の十分な安全対策を施すことを推奨いたします。

13. 代表特性例 (注)

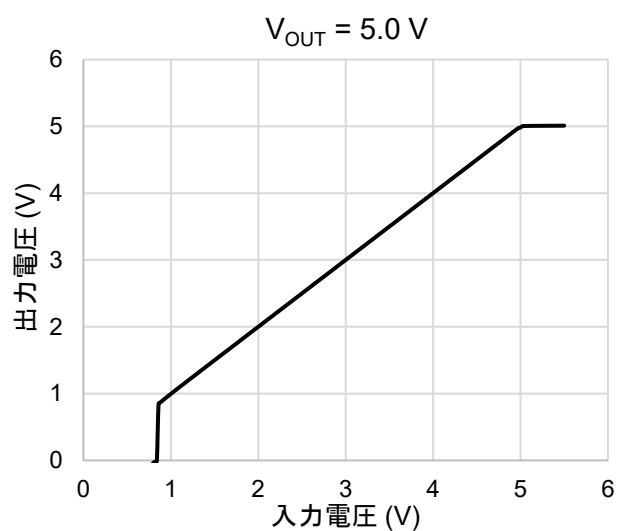
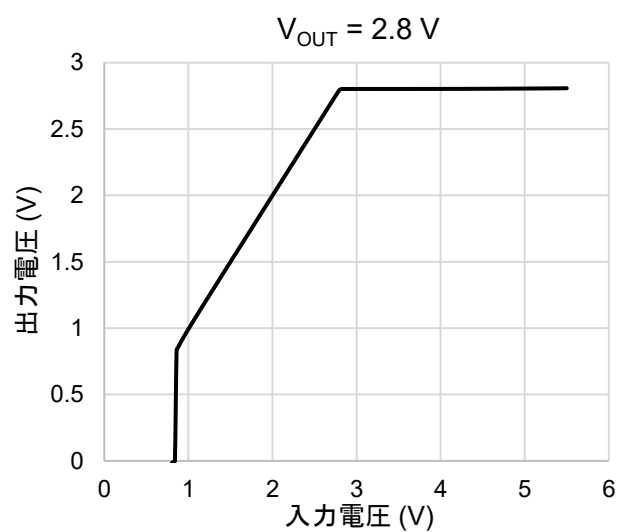
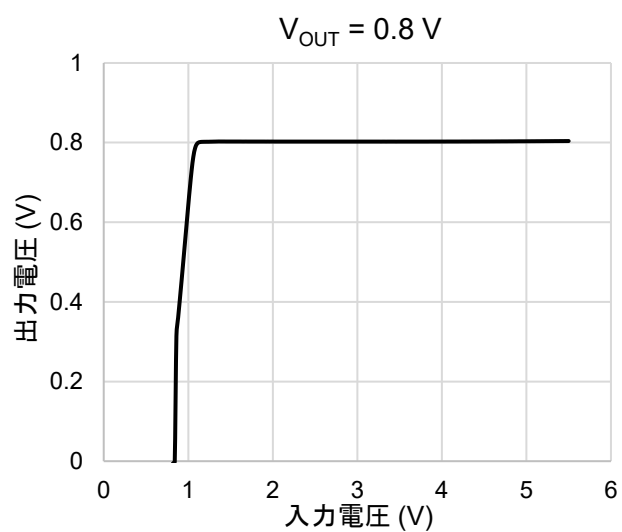
13.1. 出力電圧－出力電流特性

($V_{IN} = 2.5\text{ V}$ ($V_{OUT} = 0.8\text{ V}$) or 3.8 V ($V_{OUT} = 2.8\text{ V}$) or 5.5 V ($V_{OUT} = 5.0\text{ V}$))



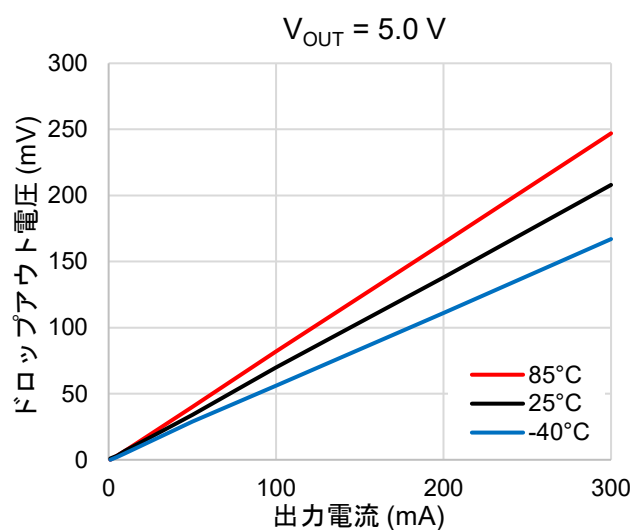
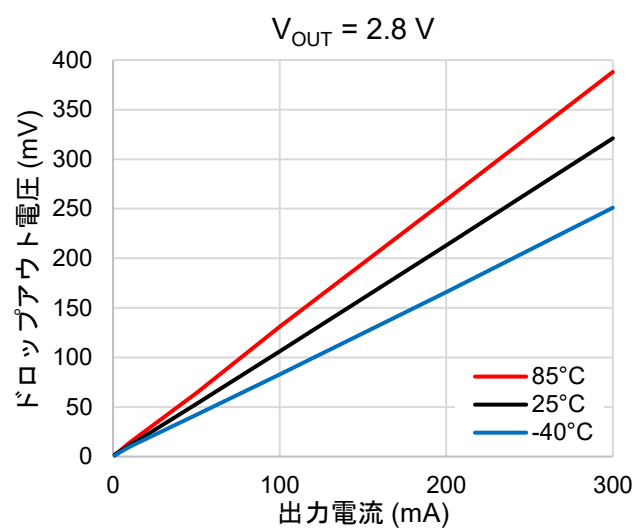
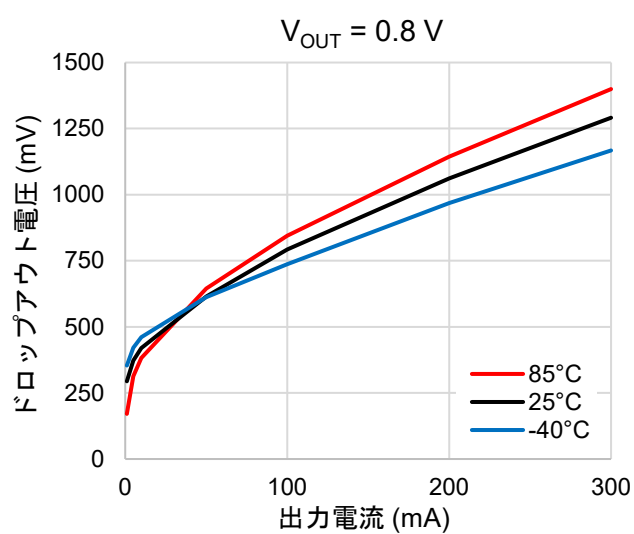
注: 上記のデータは参考値です。

13.2. 出力電圧—入力電圧特性

 $(I_{OUT} = 1\text{ mA}, T_a = 25^\circ\text{C})$ 

注: 上記のデータは参考値です。

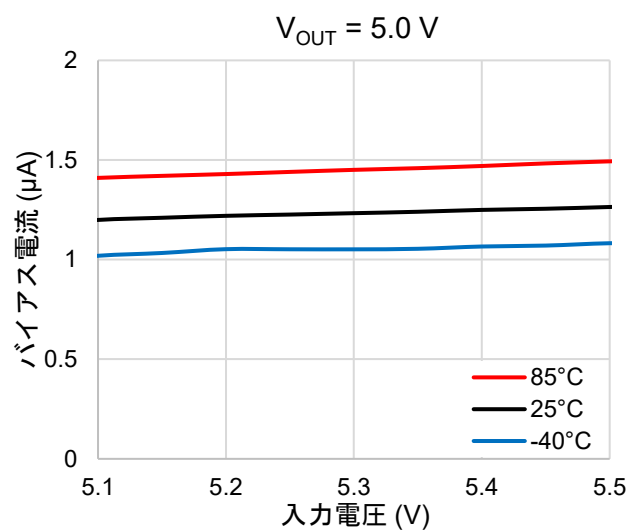
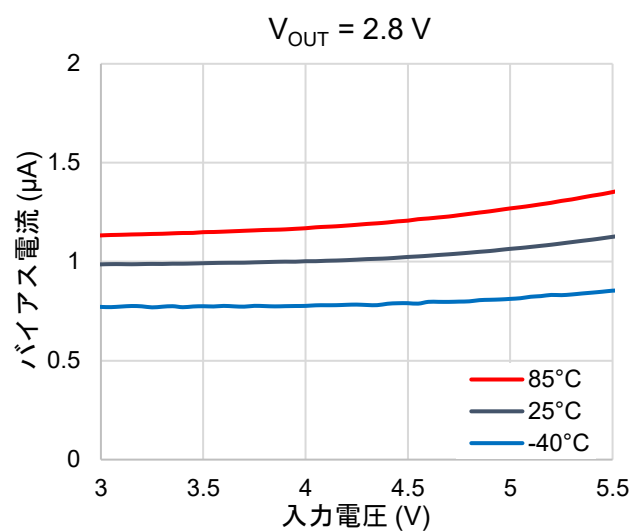
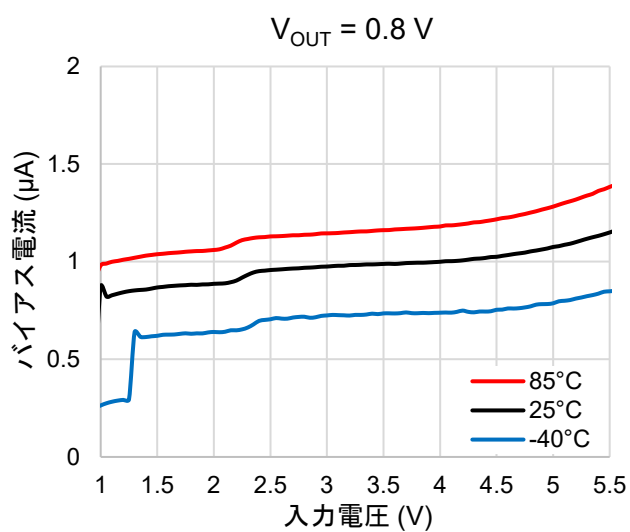
13.3. ドロップアウト電圧－出力電流特性



注: 上記のデータは参考値です。

13.4. バイアス電流—入力電圧特性

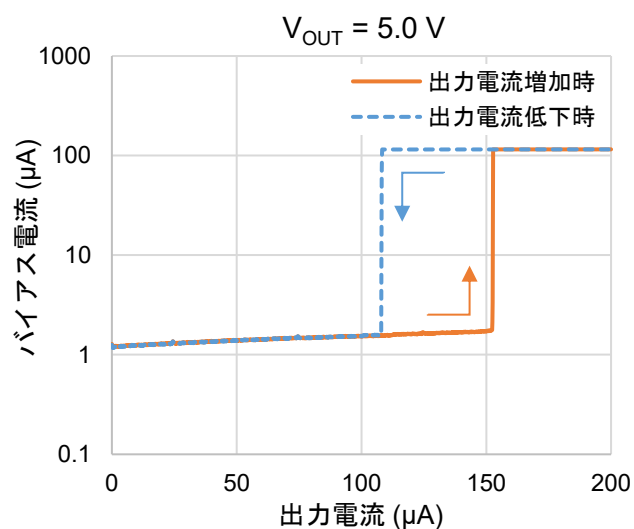
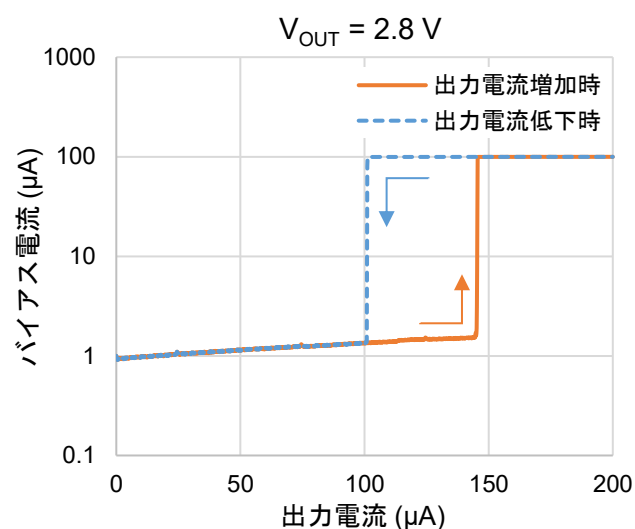
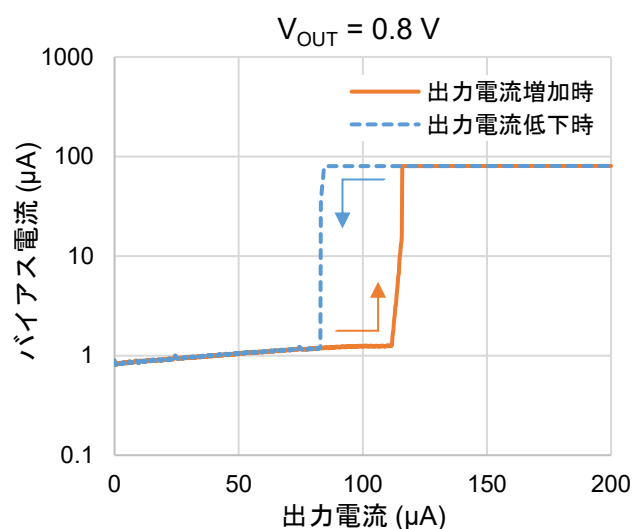
($I_{OUT} = 0 \text{ mA}$)



注: 上記のデータは参考値です。

13.5. バイアス電流－出力電流特性

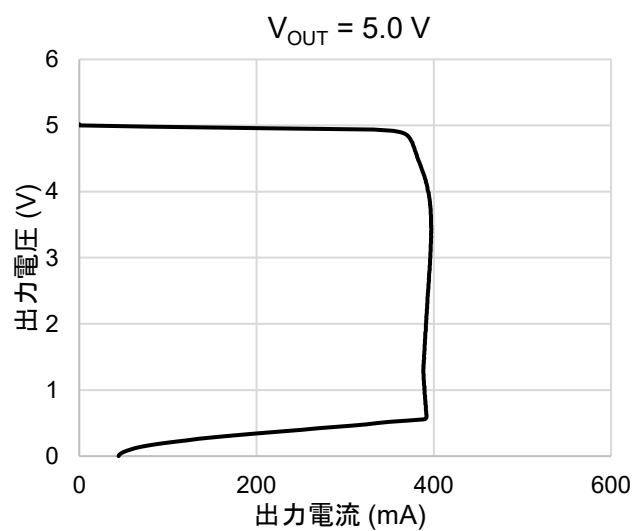
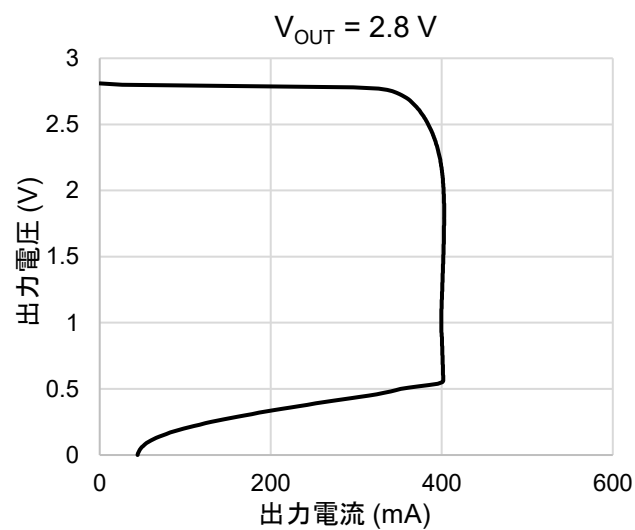
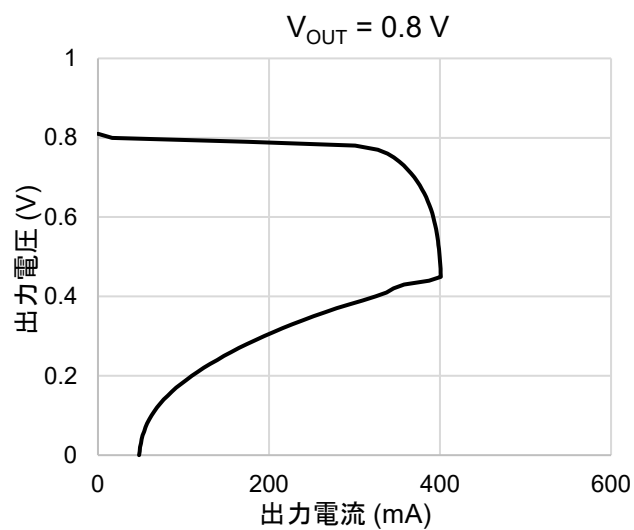
($V_{IN} = 2.5\text{ V}$ ($V_{OUT} = 0.8\text{ V}$) or 3.8 V ($V_{OUT} = 2.8\text{ V}$) or 5.5 V ($V_{OUT} = 5.0\text{ V}$), $I_{OUT} = 0\text{ A} \Leftrightarrow 200\text{ }\mu\text{A}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$)



注: 上記のデータは参考値です。

13.6. 出力制限電流特性

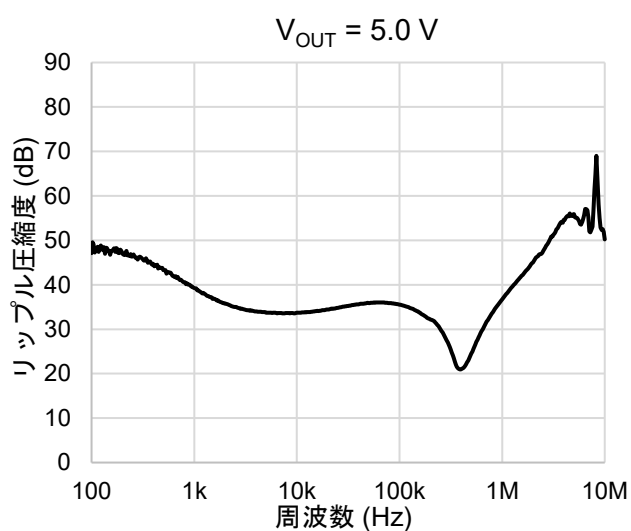
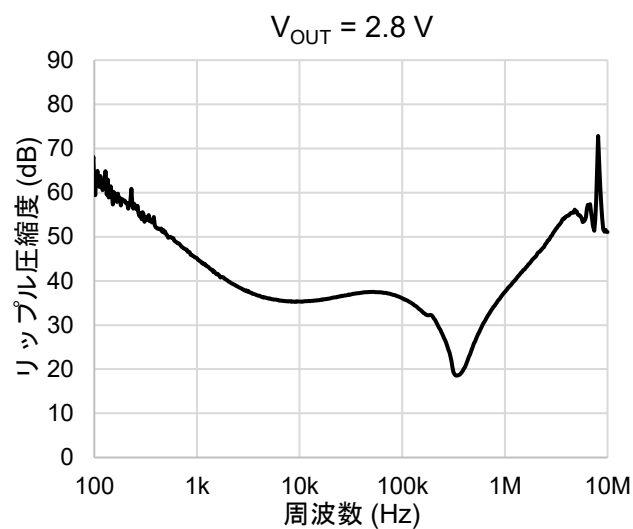
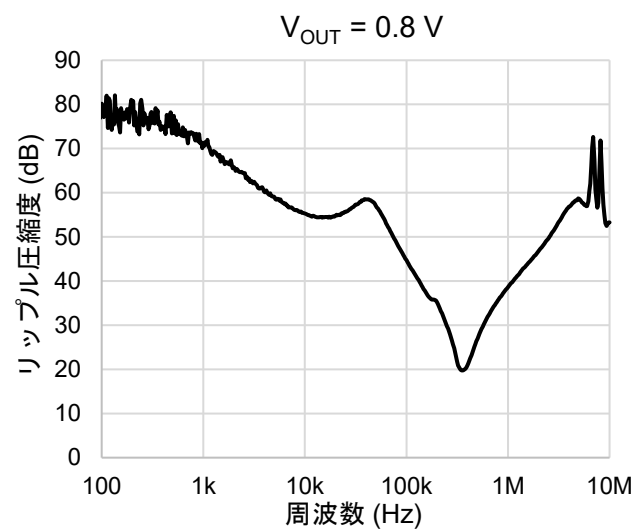
($V_{IN} = 2.5\text{ V}$ ($V_{OUT} = 0.8\text{ V}$) or 3.8 V ($V_{OUT} = 2.8\text{ V}$) or 5.5 V ($V_{OUT} = 5.0\text{ V}$), $T_a = 25^\circ\text{C}$)



注: 上記のデータは参考値です。

13.7. リップル圧縮度一周波数特性

(C_{IN} = none, C_{OUT} = 0.47 μ F, V_{IN} = 2.5 V (V_{OUT} = 0.8 V) or 3.8 V (V_{OUT} = 2.8 V) or 5.5 V (V_{OUT} = 5.0 V),
 V_{IN} Ripple = 200 mV_{p-p}, I_{OUT} = 10 mA, T_a = 25°C)

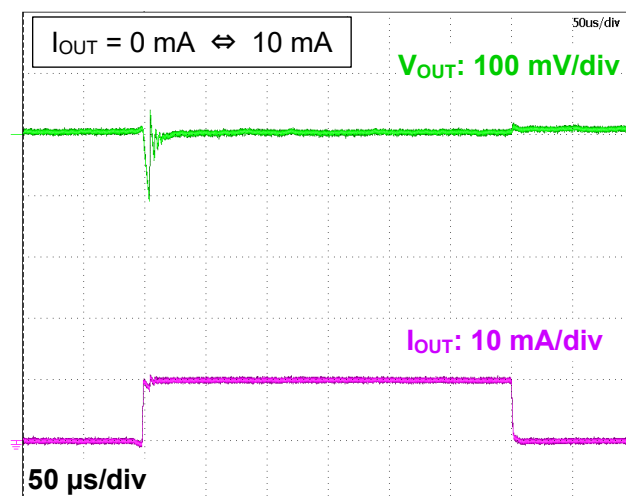
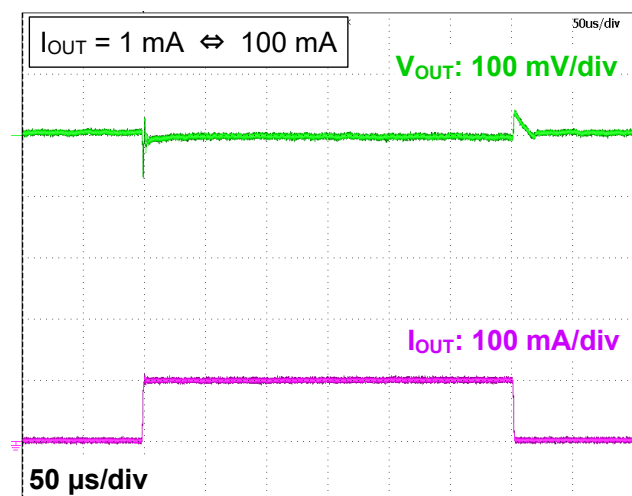


注: 上記のデータは参考値です。

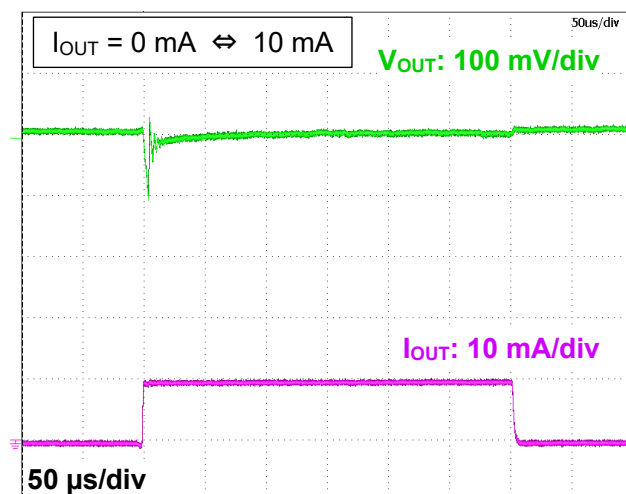
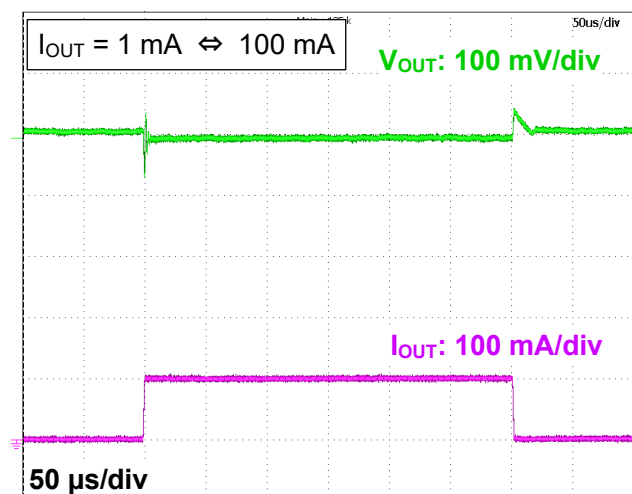
13.8. 負荷過渡応答特性

($C_{IN} = 0.47 \mu F$, $C_{OUT} = 0.47 \mu F$, $V_{IN} = 2.5 V$ ($V_{OUT} = 0.8 V$) or $3.8 V$ ($V_{OUT} = 2.8 V$) or $5.5 V$ ($V_{OUT} = 5.0 V$),
 $t_r = 1.0 \mu s$, $t_f = 1.0 \mu s$, $T_a = 25 ^\circ C$)

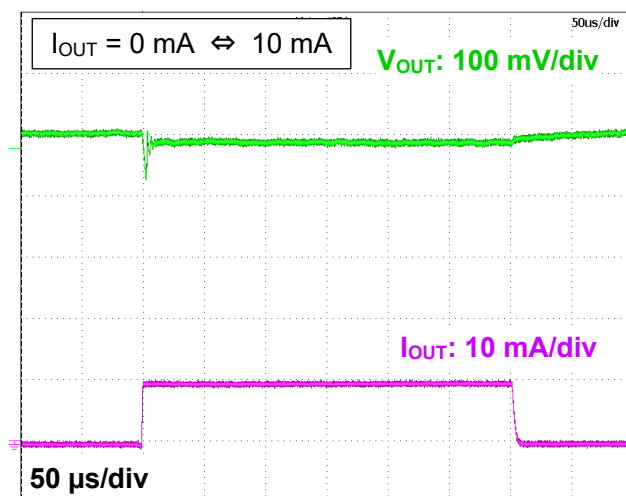
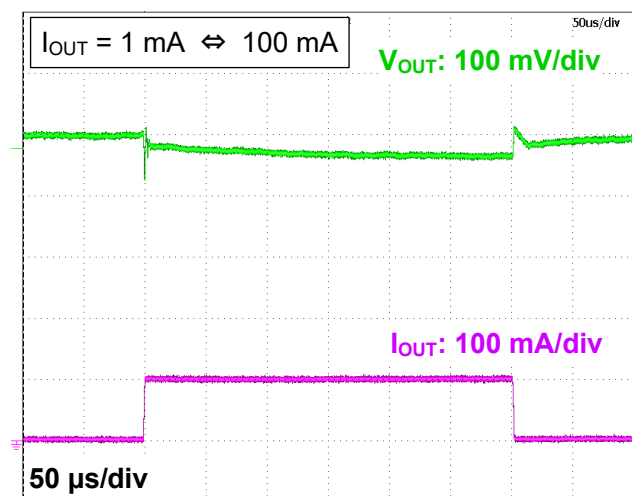
$V_{OUT} = 0.8 V$



$V_{OUT} = 2.8 V$



$V_{OUT} = 5.0 V$

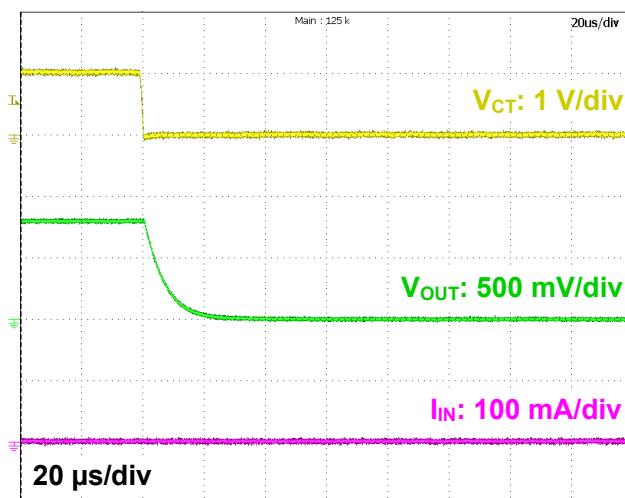
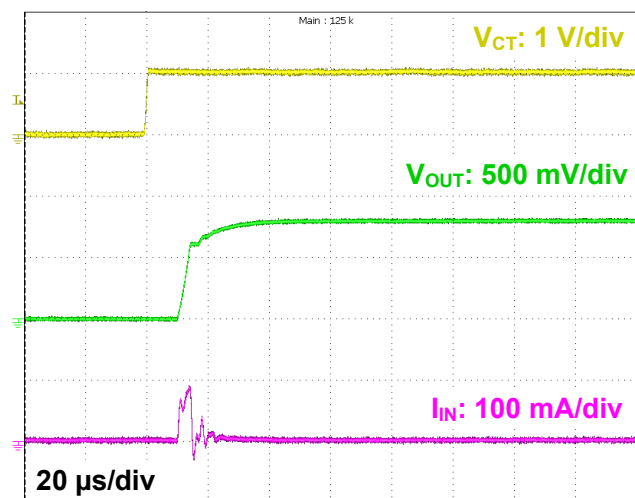


注: 上記のデータは参考値です。

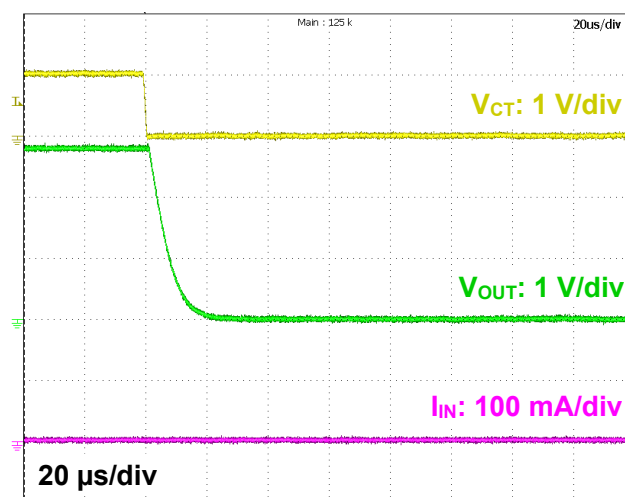
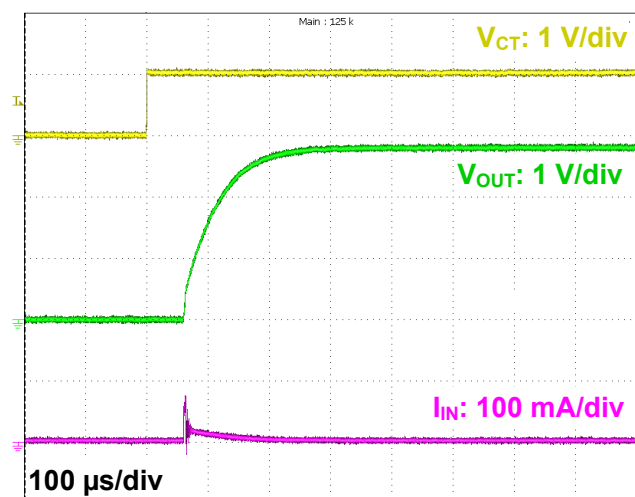
13.9. t_{ON}/t_{OFF} 応答特性

($C_{IN} = 0.47 \mu F$, $C_{OUT} = 0.47 \mu F$, $V_{IN} = 2.5 V$ ($V_{OUT} = 0.8 V$) or $3.8 V$ ($V_{OUT} = 2.8 V$) or $5.5 V$ ($V_{OUT} = 5.0 V$), $I_{OUT} = 0 mA$, $V_{CT} = 0 V \Leftrightarrow 1.0 V$, $T_a = 25 ^\circ C$)

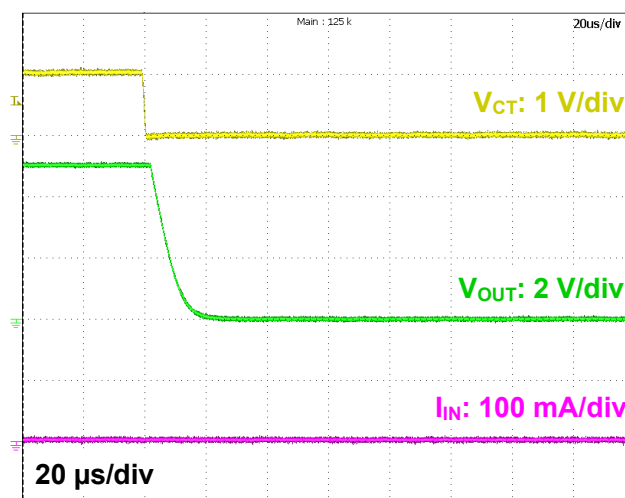
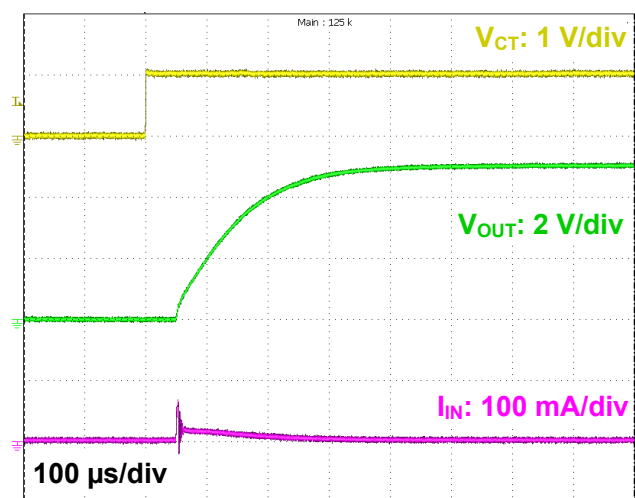
$V_{OUT} = 0.8 V$



$V_{OUT} = 2.8 V$



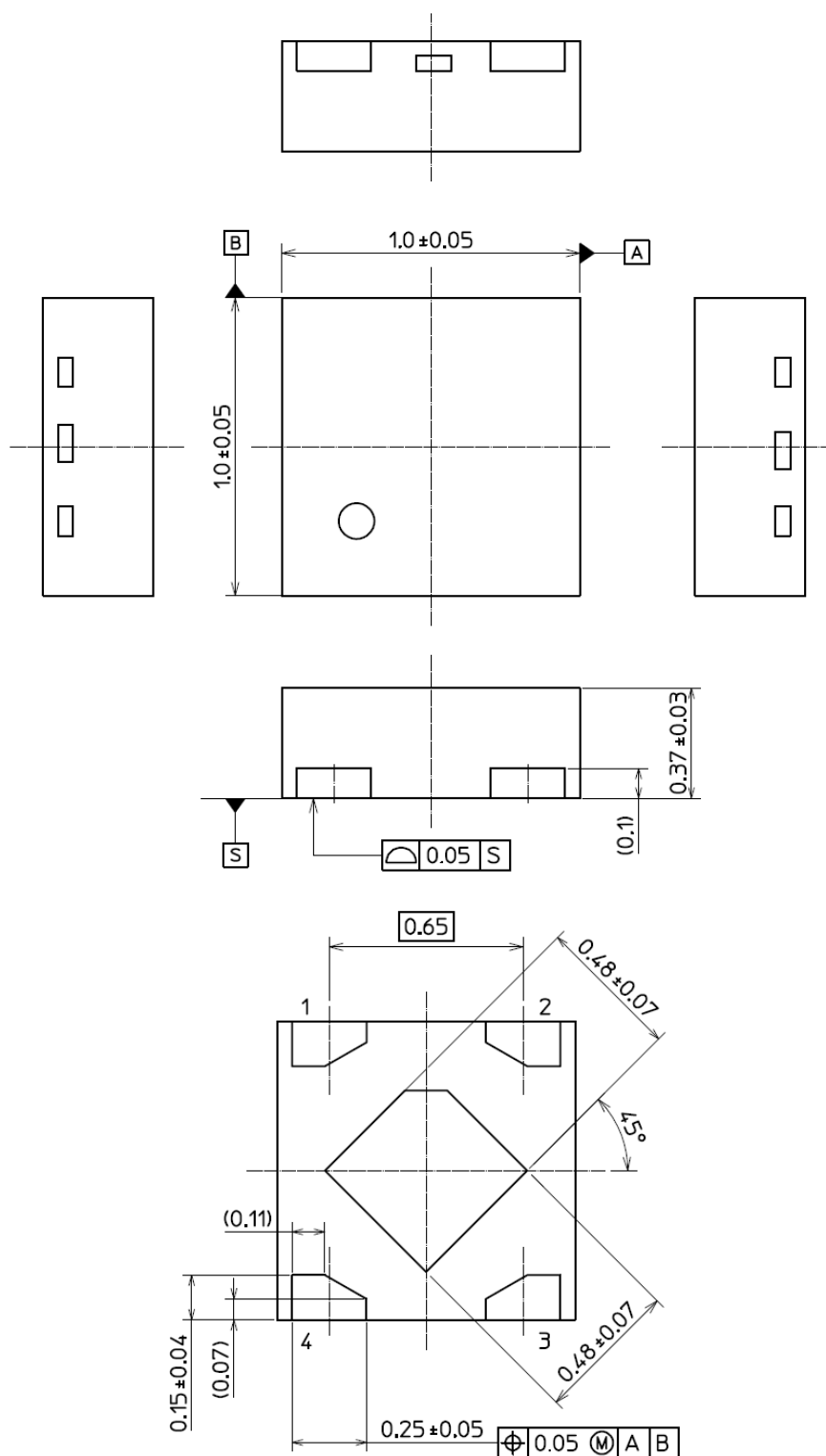
$V_{OUT} = 5.0 V$



注: 上記のデータは参考値です。

DFN4D

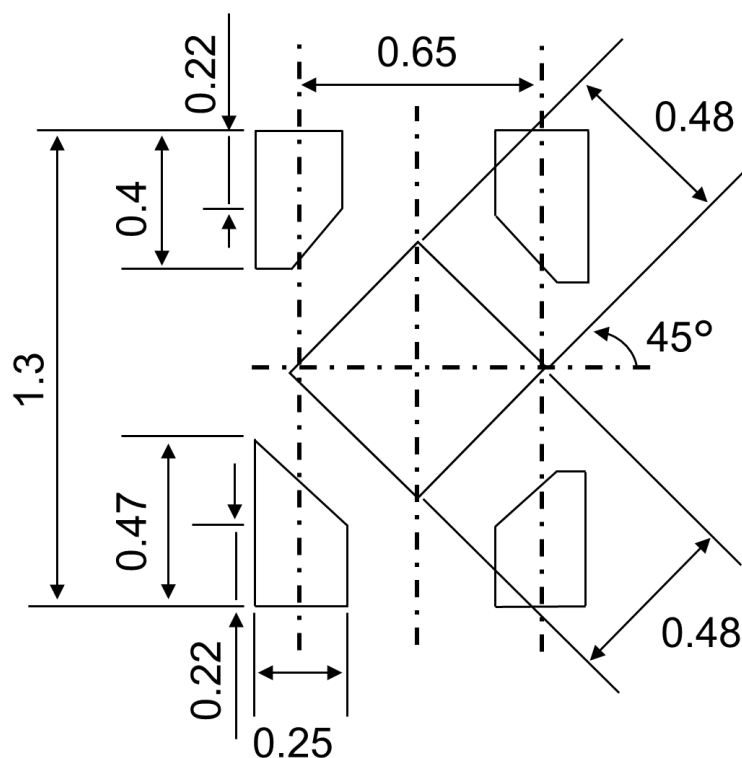
單位: mm



質量: 1.1 mg (標準)

15. 参考ランドパターン

単位: mm



製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（生命直結機器）、車載・輸送機器、防衛関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

東芝デバイス&ストレージ株式会社

<https://toshiba.semicon-storage.com/jp/>